

ImPACT佐橋プログラム 未来を拓く 公開総括成果報告会

日時：2019年3月4日(月) 9:00～20:15

場所：国立研究開発法人科学技術振興機構 東京本部別館 (1階ホール+2階会議室2A)

9:00 ~ 9:05	開会挨拶	佐橋 政司	ImPACT プログラム・マネージャー
9:05 ~ 9:15	来賓ご挨拶	須藤 亮	内閣府 政策参与 SIP/PRISM/ImPACTプログラム統括
9:15 ~ 9:25	来賓ご挨拶	平井 淳生	経済産業省 研究開発課 課長
9:25 ~ 9:55	ImPACT佐橋プログラムが切り拓く安全・安心かつ持続可能な高度知的エゴ社会の実現 -プログラムの総括成果報告-	佐橋 政司	ImPACT プログラム・マネージャー
不揮発性メモリの高速性の追求とシステムオンチップへの応用展開			
9:55 ~ 10:35	STT-MRAMを活用した超低消費電力不揮発性マイコンの開発と機能実証	遠藤 哲郎	東北大学
10:35 ~ 11:05	新概念メモリVoCSMの開発	與田 博明	東芝 研究開発センター
11:05 ~ 11:15	Startup Venture 設立の趣旨	與田 博明	Spin-Orbitronics Technologies, Inc.
11:15 ~ 11:55	スピン軌道トルク(SOT)素子の高速動作原理検証とSOT-MRAMの開発	深見 俊輔 佐藤 英夫	東北大学
基調講演 I			
11:55 ~ 12:35	IoTシステム将来展望とスピントロニクスへの期待	日高 秀人	ルネサスエレクトロニクス株式会社
12:35 ~ 14:00 昼食およびポスターセッション			
基調講演 II			
14:00 ~ 14:40	不揮発性メモリ技術とその応用への期待	土田 賢二	東芝メモリ株式会社 メモリ技術研究所
究極の超省電力不揮発性メモリの実現を目指した電圧駆動MRAMの開発と応用展開			
14:40 ~ 15:30	電圧駆動MRAMの成立性への挑戦と新たな応用展開への模索	野崎 隆行	産業技術総合研究所
15:30 ~ 16:10	「Voltage Control Spintronics Memory (VoCSM)の応用展開 -IoTエッジからクラウドまでのメモリアーキテクチャー」	藤田 忍	東芝 研究開発センター
16:10 ~ 17:00 デモンストレーション展示、ポスターセッションおよびCoffee Break			
更なる高機能化を目指した挑戦と新たな原理の発見			
17:00 ~ 17:40	単結晶磁気トンネル接合(MTJ)の開発と世界初の3次元積層技術への挑戦 -電圧駆動MRAM実用化のためのMTJ材料開発の選択肢の拡大-	湯浅 新治	産業技術総合研究所
17:40 ~ 18:30	電氣的に原子の形を変えることで超省エネ磁気メモリを実現する新原理の発見	三輪真嗣 白井正文	大阪大学 (現東京大学) 東北大学
18:30 ~ 18:35	閉会挨拶	佐橋 政司	ImPACT プログラム・マネージャー
18:35 ~ 18:45 移動			
18:45 ~ 20:15 意見交換交流会			